



Hysteresis in magnetic materials

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پروژه درس الکترومغناطیس

استاد: دکتر آذر تفریحی

اعضاء گروه:

فائزه جمشیدی

نگار پرداختیم

مریم راعی

بهاره السادات بحرینیان

نفیسه سلیمانی

نرگس پاکدل

زهره غلامی

محمدحسین مهاجر

امیرمحمد احمدیان

فهرست :

1 تعریف پدیده پسماند

2 مواد مغناطیسی نرم و سخت

3 علت پسماند مغناطیسی چیست؟

4 بررسی نمودار پسماند (هیستریزیس)

5 فرمول ها و روابط

6 کاربرد های منحنی پسماند

7 تلفات منحنی پسماند

تعریف پدیده پسماند :

وقتی به یک ماده مغناطیسی میدان مغناطیسی اعمال شود، مغناطش محیط سریع افزایش می یابد.

با افزایش مقدار میدان اعمالی، شتاب افزایش مغناطش کاهش می یابد.

این کاهش شتاب ادامه می یابد تا مغناطش محیط به مقدار اشباع خود M_S برسد.

تغییرات مغناطش مواد مغناطیسی در هنگام کاهش میدان، از رفتار قبلی خود تبعیت نمی‌کند؛ بلکه بخاطر ناهمسانگردی مغناطیسی در محیط، مقداری انرژی را در خود ذخیره می‌کنند.



بنابراین وقتی میدان اعمالی در محیط صفر شود؛ مغناطش در ماده صفر نشده و دارای مقدار خاصی است که به آن مغناطش پسماند M_r گفته می‌شود.




با کاهش بیشتر شدت میدان به سمت مقادیر منفی، خاصیت مغناطیسی القا شده به تدریج کاهش می‌یابد و با رسیدن شدت میدان به یک مقدار منفی خواص مغناطیسی ماده کاملاً از بین می‌رود. ✓

این میدان مغناطیسی زدا را با H_c نشان می‌دهند و به نیروی ضدپسماند و یا وادارندگی مغناطیسی معروف است. ✓

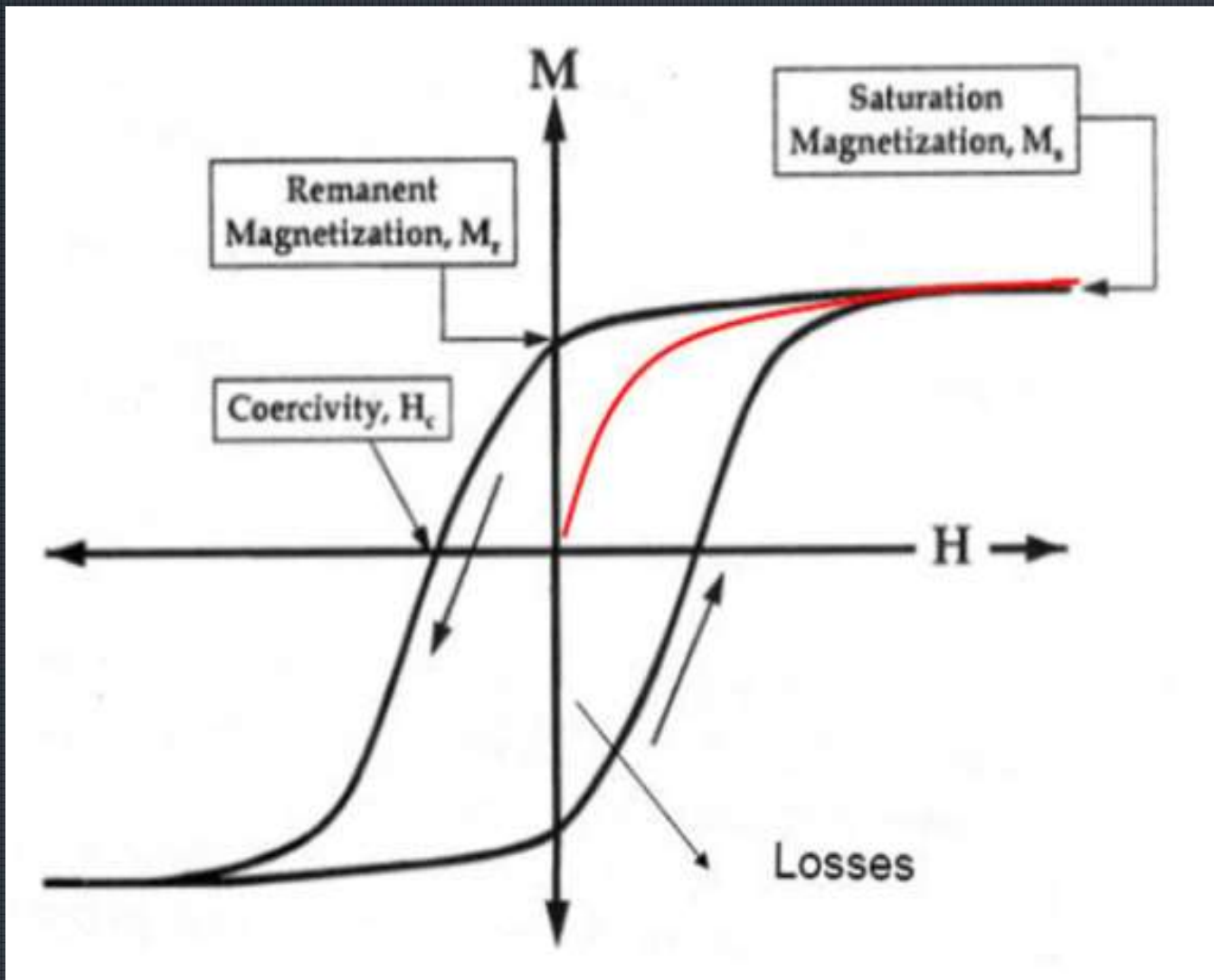
با کاهش بیشتر شدت میدان، القای مغناطیسی منفی می‌شود و در نهایت به مقادیر اشباع منفی خود، می‌تواند برسد. ✓

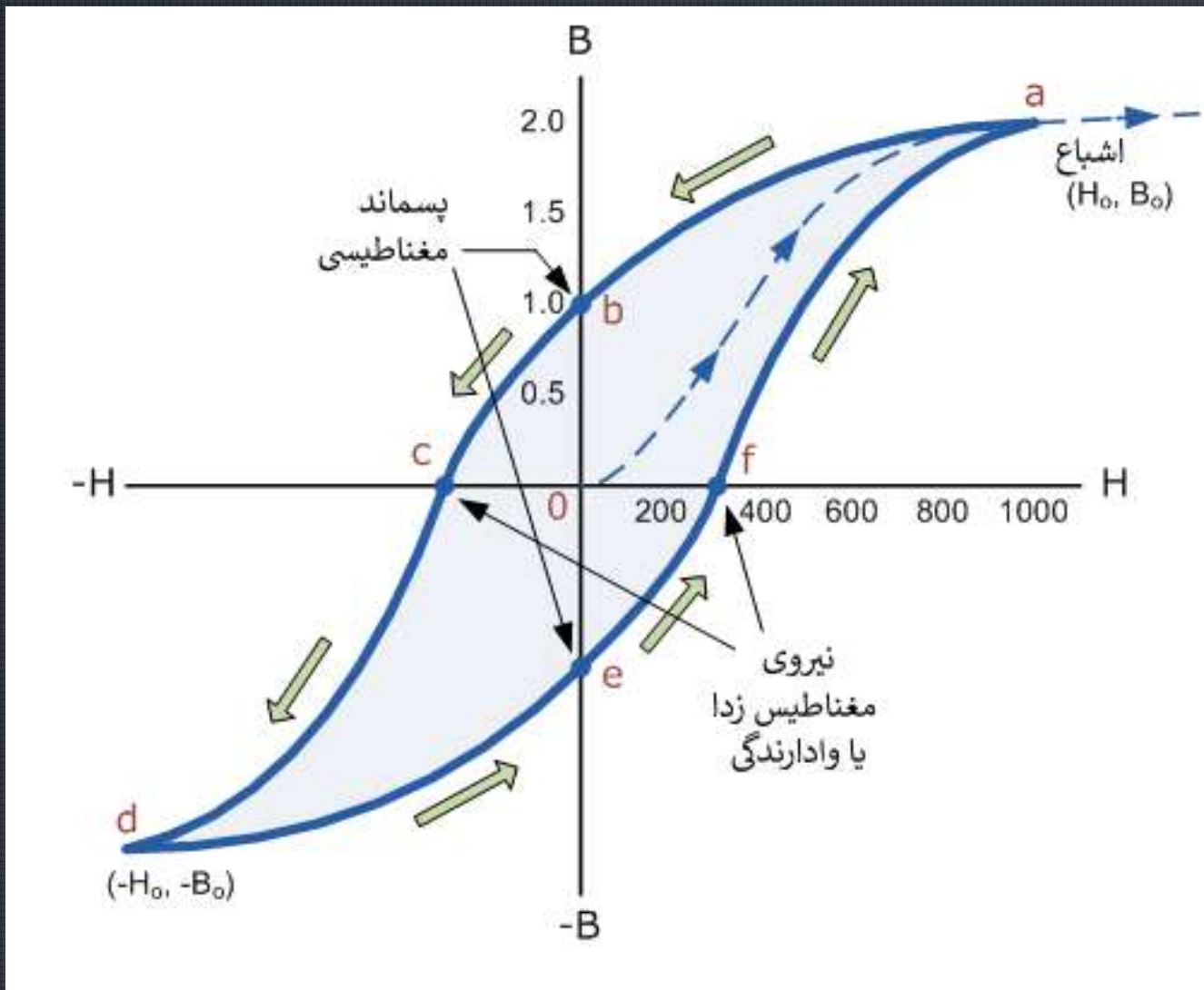
افزایش مجدد شدت میدان به سمت مقادیر مثبت، حلقه پسماند را کامل می‌کند. ✓



مغناطیس‌های دائمی غالباً در ربع دوم حلقه پسماند خود، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پسماند یا نیروی وادارنده عبارتست از میدان معکوسی که برای کاهش مغناطش به صفر نیازست.





مواد مغناطیسی نرم و سخت :

مواد مغناطیسی از نظر رفتار آنها در میدان مغناطیسی به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

نرم

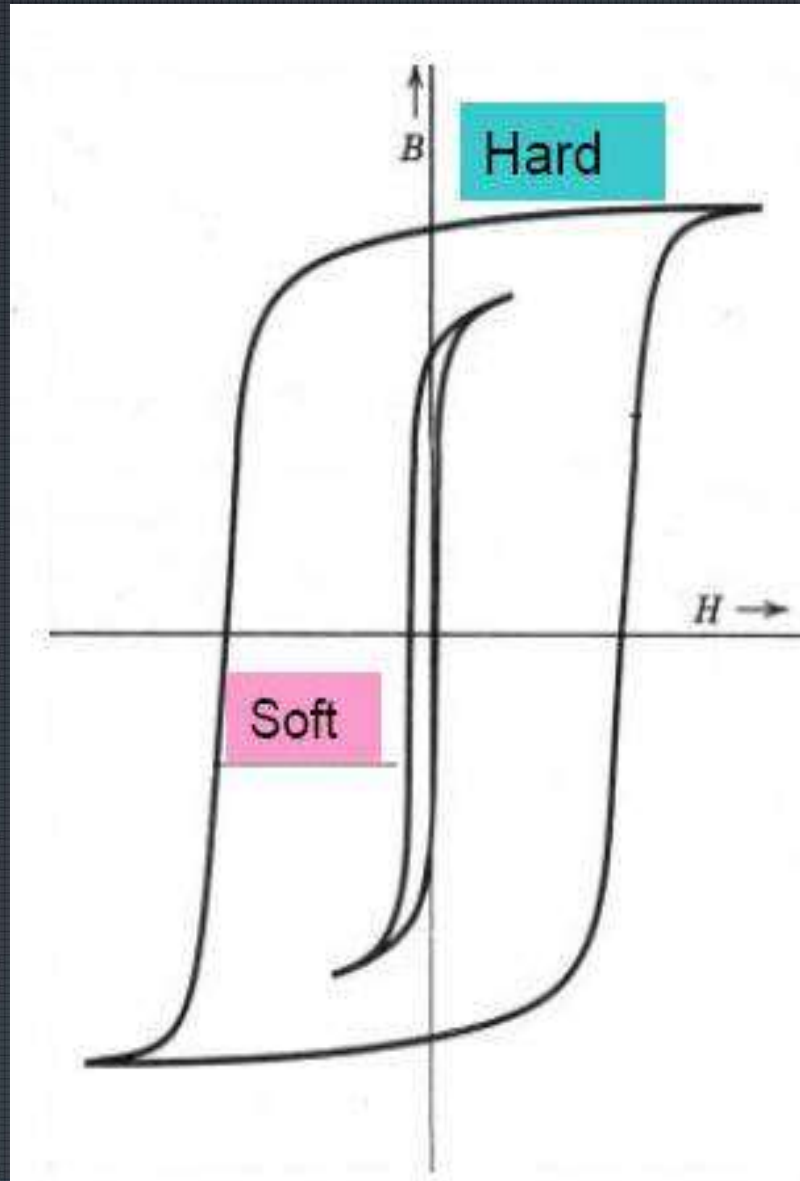
سخت

مواد مغناطیسی نرم:

- ✓ مواد مغناطیسی نرم با اعمال میدان مغناطیسی کوچک براحتی مغناطیده می‌شود و با قطع میدان سریعاً گشتاور مغناطیسی خود را از دست می‌دهند.
- ✓ به عبارتی این مواد دارای نیروی وادارندگی پایینی هستند.
- ✓ این مواد دارای اشباع مغناطیسی بالا M_s و گشتاور مغناطیسی M_r پایین اند.
- ✓ مواد مغناطیسی نرم در جاهایی که به تغییر سریع گشتاور مغناطیسی با اعمال میدان مغناطیسی کوچک نیاز است، مانند موتورها، هدهای مغناطیسی، حسگرها، القاگرها و فیلترهای صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مواد مغناطیسی سخت :

- ✓ مواد مغناطیسی سخت موادی اند که براحتی مواد مغناطیسی نرم، مغناطیده نمی شوند و به میدان مغناطیسی اعمالی بزرگتری، جهت مغناطیده کردن آنها نیاز است.
- ✓ این مواد، گشتاور مغناطیسی را تا مدت‌ها پس از قطع میدان مغناطیسی در خود حفظ می کنند.
- ✓ همچنین دارای اشباع مغناطیسی M_s گشتاور پسماند M_r و نیروی وادارندگی H_c بالایی هستند.
- ✓ ساخت یا پخت این مواد در میدان مغناطیسی، ناهمسانگردی مغناطیسی را در این مواد افزایش می دهد؛ که حرکت دیواره حوزه‌ها را سخت تر می کند و نیروی وادارندگی را افزایش می دهد. این امر می تواند تولید ماده سخت مغناطیسی بهتری را تضمین کند.
- ✓ کاربرد این مواد در آهنرباهای دائمی و حافظه‌های مغناطیسی است.



علت پسماند مغناطیسی چیست ؟

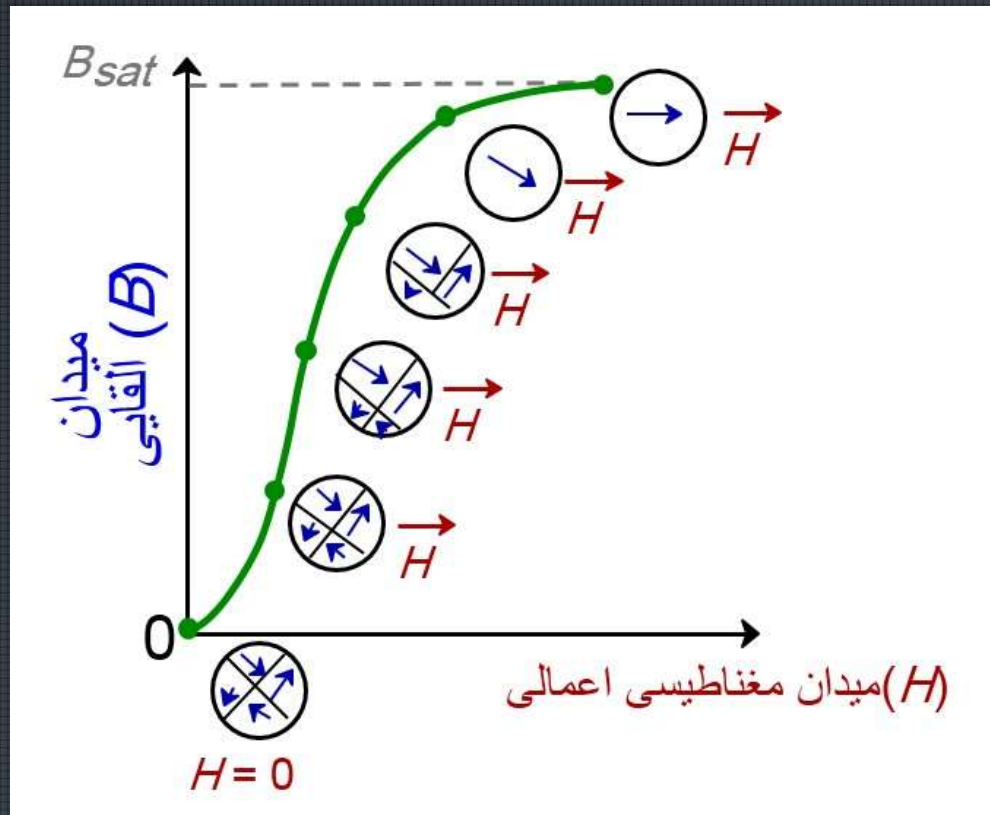
اختلاف بین آهنک افزایش در مغناطش یک ماده فرومغناطیس با ازدیاد H و طریق وامغناطش آن با H رو به کاهش ، نشان می دهد، وقتی که مغناطش ماده فرومغناطیس تغییر می کند، یعنی وقتی که شدت میدان مغناطیسی خارجی افزایش یا کاهش می یابد، جهت گیری یا درهم شدن جهت های آهنرباهای بنیادی بلافاصله بعد از عوض شدن میدان پیش نمی آید، بلکه بعد از یک تأخیر زمانی معین رخ می دهد. تحلیل تفصیلی مغناطش و وامغناطش آهن و دیگر مواد فرومغناطیسی نشان می دهد که خواص فرومغناطیسی ماده را فقط خواص مغناطیسی اتم ها و مولکول های منفرد ، که خودشان پارامغناطیس هستند تعیین نمی کنند، بلکه توسط مغناطش ناحیه های کاملی به نام حوزه تعیین می شود (به این دلیل این نظریه را اغلب نظریه حوزه می نامند).

این اصطلاح به ناحیه‌های کوچکی در ماده اطلاق می‌شود که دارای شمار زیادی اتم هستند. اندرکنش گشتاورهای مغناطیسی اتمهای منفرد در فرومغناطیس به شکل گیری میدانهای مغناطیسی ذاتی خیلی قوی منفجر می‌شود که در هر حوزه عمل می‌کنند و در داخل چنین ناحیه‌ای همه آهنرباهای اتمی را موازی با یکدیگر آرایش می‌دهند که خود بخود تا حد اشباع مغناطیسی هستند. اما جهت‌های مغناطش در حوزه‌های مختلف، متفاوت هستند. بنحوی که در نبود میدان مغناطیسی خارجی به علت توزیع نامنظم این نواحی جسم نامغناطیده است. بر اثر میدان مغناطیسی خارجی، این ناحیه‌های مغناطش خود بخود از نو مرتب و گروه بندی می‌شوند. در نتیجه، ناحیه‌هایی که در آنها مغناطش با میدان خارجی موازی است غالب می‌شوند و ماده در کل حالت مغناطیسی پیدا می‌کند. نظر به اندازه بزرگ ناحیه‌های مغناطش خود بخود در مقایسه با ابعاد اتمی، جهتگیری (و نیز فرایند عکس یعنی بهم خوردن جهت‌ها) این ناحیه‌ها با دشواری‌های بیشتری برخورد می‌کند تا حالت اتمها و مولکولهای منفرد در پارامغناطیسها و دیامغناطیسها. به این دلیل، پشت سر تغییرات میدان خارجی مغناطش و وامغناطش قرار دارد، یعنی پسماند مشاهده می‌شود.

نمودار هیستریزیس :

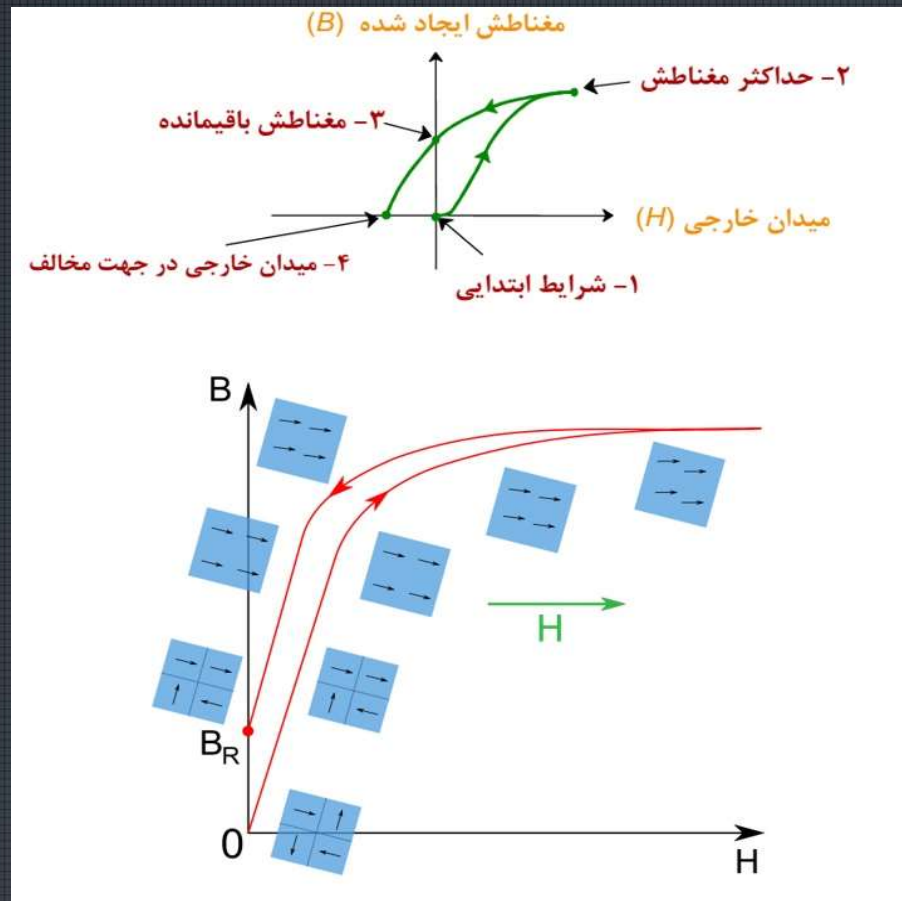
نمودار نحوه مغناطیسی شدن ماده بر حسب میدان اعمالی را نمودار هیستریزیس گویند. از این نمودار پارامترهای مختلف مغناطیسی را می توان استخراج کرد. **شکل ۱** بخشی از این نمودارها را نشان می دهد؛ اگر یک ماده مغناطیسی که در ابتدا هیچ گونه مغناطشی ندارد، ابتدا دومین های همسوتر با میدان (H) در نظر گرفته شود، با اعمال میدان مغناطیسی خارجی در ازای کاهش حجم دومین های ناهمسو، رشد می کنند تا این که ماده تک دومین شود. در ادامه وقتی ماده تک دومین شد، این تک دومین کاملاً می چرخد تا در جهت میدان قرار گیرد.

در این حالت، حداکثر مقدار مغناطیسی در ماده مشاهده می شود. به این میزان مغناطیس، مغناطش اشباع B_s گویند.



شکل شماره ۱

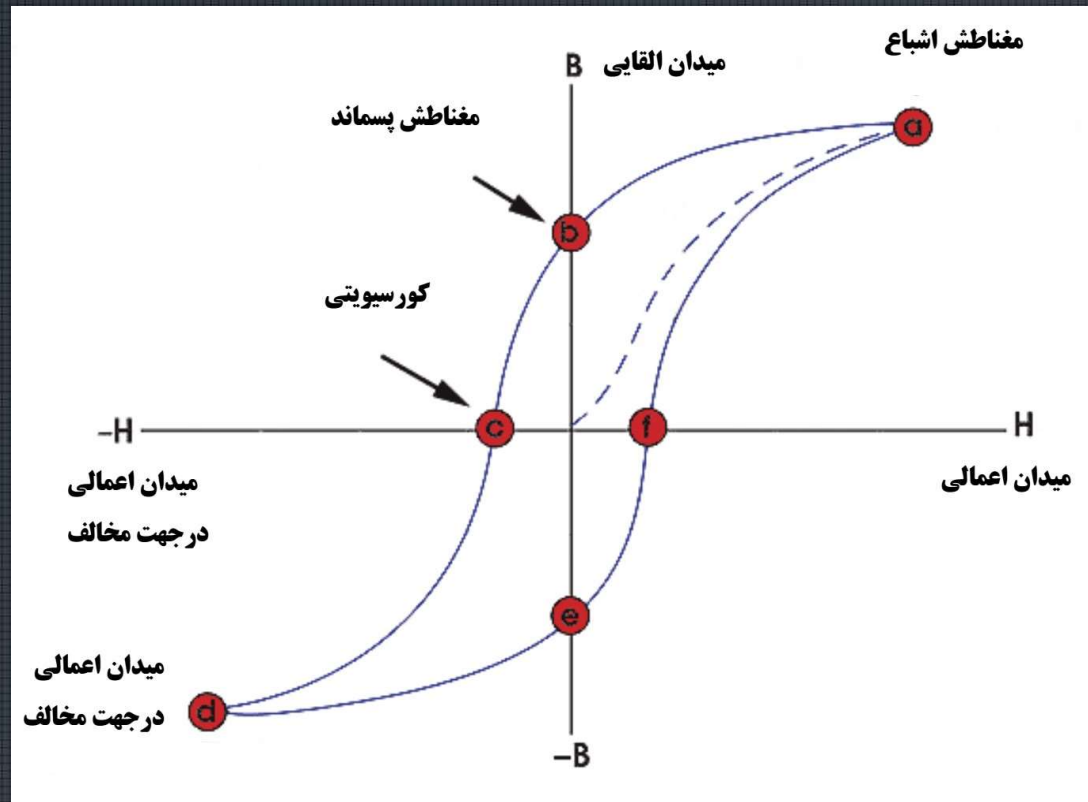
همان گونه در **شکل ۲** مشاهده می شود، بعد از رسیدن به مغناطش اشباع، با کاهش میدان مغناطیسی اعمالی، مسیر برگشت مانند مسیر ابتدایی نیست. حتی وقتی میدان اعمالی صفر می شود هنوز مقداری مغناطش درون ماده وجود دارد. همان گونه که شکل هم گویا آن است، به دلیل باقی ماندن بخشی از دومین های همسو با میدان خارجی، در ماده وجود دارد. این مغناطش (BR) مقداری مغناطش به نام مغناطش پسماند پسماند توضیحی است بر این که چرا بعضی مواد با این که میدان خارجی وجود ندارد، دارای مغناطش هستند.



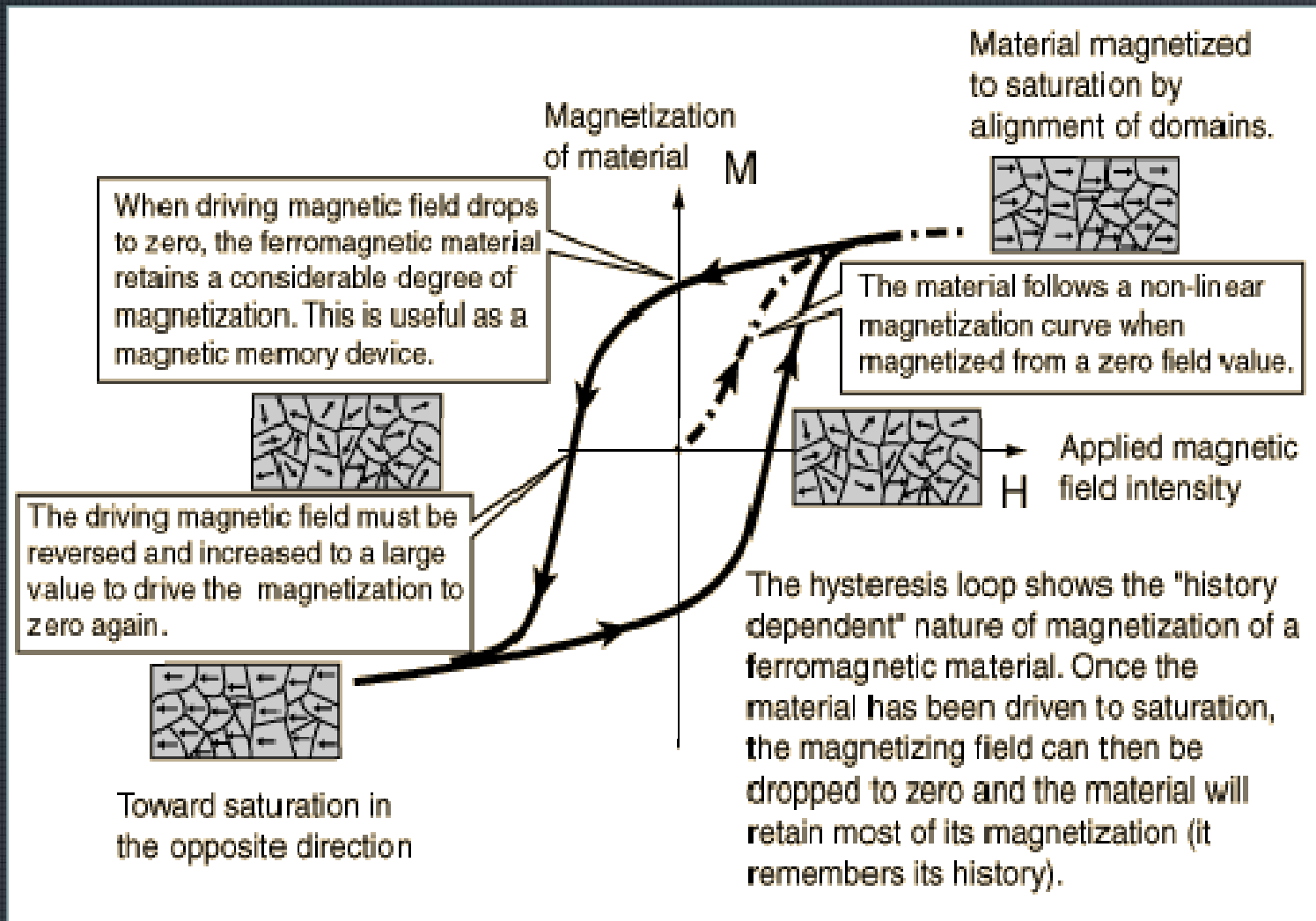
شکل شماره ۲

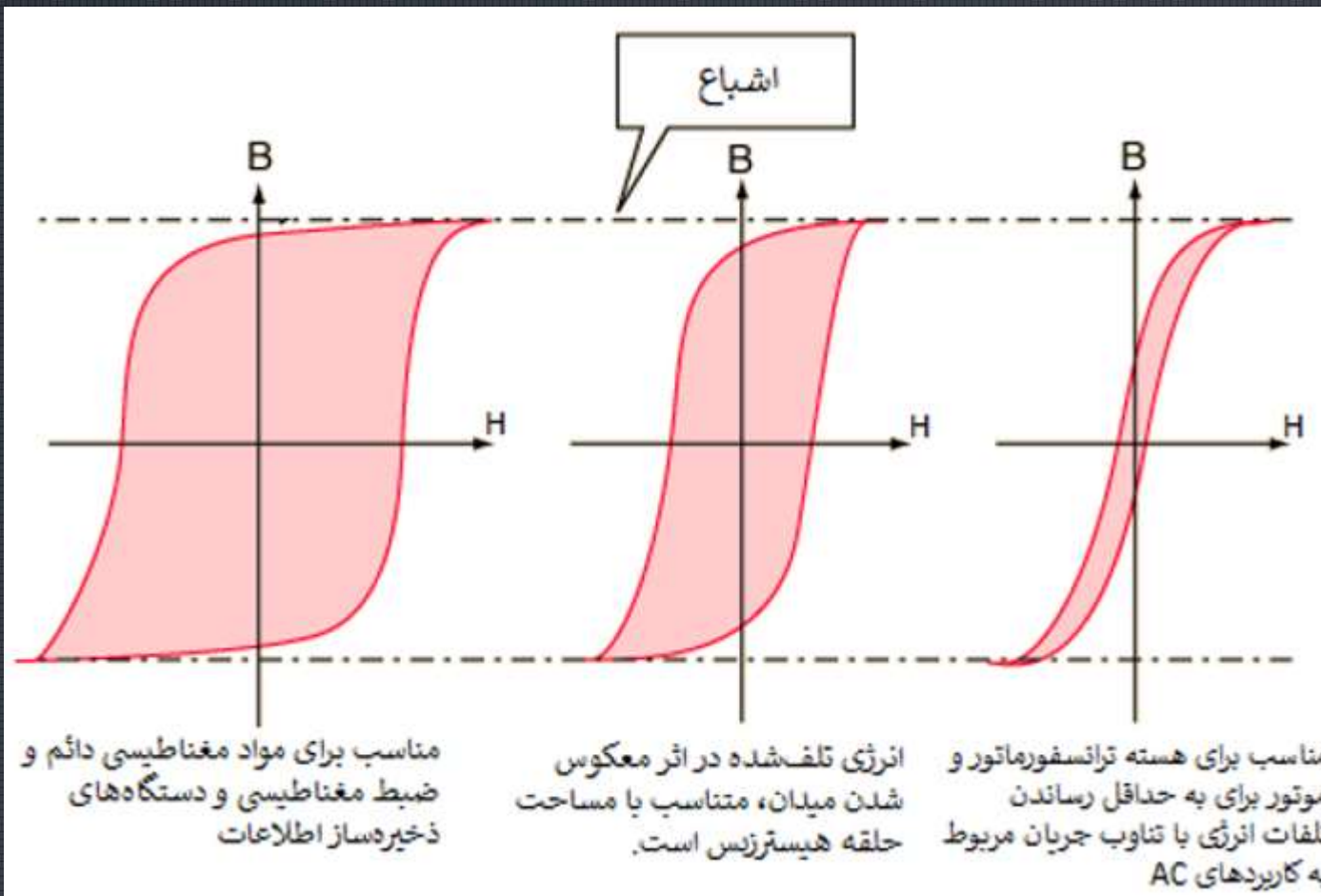
مطابق **شکل ۳** اگر میدان خارجی اعمالی برعکس شود، مغناطش پسماند کاهش می‌یابد تا این که با افزایش این میدان خارجی بتوان مغناطش داخلی پسماند را صفر کرد. میدان خارجی اعمالی را که قادر است مغناطش موجود در ماده را صفر کند، کورسیویتی می‌نامند.


بعد از صفر شدن مغناطش داخلی، با ادامه اعمال میدان، مغناطش معکوس در ماده ایجاد شده که در نهایت به مغناطش اشباع عکس می‌رسد. مقدار این مغناطش اشباع عکس درست برابر مغناطش اشباع مستقیم است، فقط جهت متفاوتی دارد. با تغییر جهت میدان (برگشت به جهت اولیه) مسیر طی شده توسط ماده مغناطیسی حلقه فقط در اولین مرحله اعمال میدان مغناطیسی است که هیستریزیس آبی رنگ را می‌سازد. منحنی خط‌چین ایجاد می‌شود، در حالی که مسیر طی شده در مراحل بعد یک حلقه هیستریزیس پیوسته می‌سازد.



شکل شماره ۳






$$\epsilon = N \frac{d\phi}{dt}$$


$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt$$
$$= \int_{t_1}^{t_2} \epsilon i dt$$

$$W = \int N \frac{d\phi}{dt} \cdot i dt$$
$$= \int_{\phi_1}^{\phi_2} Ni d\phi$$

فرمول ها و روابط :

$$\varphi = BA \quad \text{and} \quad i = H \frac{L}{N} \quad \longrightarrow \quad w = \int_{B_1}^{B_2} N \cdot H \frac{L}{N} A dB$$
$$= LA \int_{B_1}^{B_2} H dB$$
$$= (V_{core}) \int_{B_1}^{B_2} H dB$$

$$W_{cycle} = V_{core} \oint H dB = V_{core} \times \text{area of the } B - H \text{ loop}$$
$$= V_{core} \times W_h$$



where $W_h = \oint H dB$

is the energy density in the core (= area of the B—H loop).

The power loss in the core due to the hysteresis effect is

$$P_h = V_{core} W_h f$$

Where f is the frequency of variation of the current i .



area of B – H loop = $K B_{max}^n f$

$$P_h = K B_{max}^n f$$

کاربرد های منحنی پسماند :

پدیده هیستریزیس در مواد فرو مغناطیس کاربردهای بسیار متنوعی دارد. در بسیاری از موارد، قابلیت های این پدیده برای ذخیره حافظه های به کار رفته در وسایلی نظیر نوارهای مغناطیسی، هارد درایوها و کارت های اعتباری به کار گرفته می شوند. استفاده آهنرباهای سخت با وادارندگی بالا (مانند آهن) برای چنین کاربردهایی مناسب تر است؛ زیرا حافظه ایجاد شده بر روی این مواد به سادگی پاک نمی شود.

هارد درایورها برای ذخیره سازی اطلاعات از حافظه های مغناطیسی استفاده می کنند.

آهن دارای **وادارندگی پایین** (از نظر مغناطیسی نرم)، برای **هسته آهنرباهای الکتريکی** مورد استفاده قرار می‌گیرد. وادارندگی پایین این مواد، میزان **اتلاف انرژی** مرتبط با پدیده هیستریزيس را کاهش می‌دهد. از این‌رو، به دلیل اتلاف کمتر انرژی در حلقه هیستریزيس، از آهن نرم در هسته‌های **ترانسفورماتورها** و **موتورهای الکتريکی** استفاده می‌شود.

پدیده هیستریزيس در تغییر فازهایی که دمای ذوب و انجماد باهم مطابقت ندارند نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، ماده **آگار** در دمای ۸۵ درجه سانتی‌گراد ذوب و در دمایی بین ۳۲ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد منجمد می‌شود. باید اشاره کنیم که این ماده پس از ذوب شدن در دمای ۸۵ درجه سانتی‌گراد، حالت مایع خود را با کاهش دما تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد حفظ می‌کند. بنابراین، حالت جامد یا مایع بودن آگار در فاصله بین ۴۰ تا ۸۵ درجه سانتی‌گراد به وضعیت قبلی آن بستگی دارد (هیستریزيس الکتريکی)

کاربردهای جذاب دیگر منحنی پسماند:

به طور کلی، پدیده هیستریزیس را می‌توان در مواد فرو مغناطیس و فرو الکتریک، تغییر شکل نوارهای لاستیکی، آلیاژهای دارای حافظه شکلی و بسیاری از پدیده‌های طبیعی دیگر مشاهده کرد.

✓ نمونه‌ای از یک عینک ساخته شده با فریمی از جنس آلیاژ دارای حافظه شکلی. فریم این عینک پس از خم شدن به حالت اول بازمی‌گردد.



✓ سیستم‌های کنترل

پدیده هیستریزیس با در نظر گرفتن تاریخچه قبلی سیستم‌های کنترل می‌تواند سیگنال‌ها را به گونه‌ای فیلتر کند که **سرعت عکس‌العمل خروجی** نسبت به مواقع دیگر کمتر باشد. به عنوان مثال، ممکن است **ترموستات کنترل‌کننده یک سیستم گرمایشی** به گونه‌ای تنظیم شده باشد که با رسیدن دمای محیط به مقداری کمتر از **خاموش** شود. **B**، سیستم روشن و تا پس از رسیدن دما به مقداری **بیشتر از A**، مثلاً اگر شخصی بخواهد دمای محیط خود را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگه دارد، می‌تواند تنظیمات روشن شدن خودکار ترموستات را روی دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد و خاموش شدن خودکار آن را روی دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد قرار دهد. با استفاده از روشی مشابه می‌توان کلیدی برای تعیین آستانه خاموش/روشن شدن دستگاه **تنظیم فشار** نیز طراحی کرد



نمونه‌ای از یک ترموستات دیجیتال که برای نگه داشتن دمای اتاق در حدود ۲۱ درجه سانتی گراد تنظیم شده است.

✓ مدارهای الکترونیکی

(Noise Gate) «نویز گیت» در وسایل الکترونیکی صوتی، اغلب از یک برای ایجاد هیستریزیس به منظور جلوگیری از قطع و وصل شدن ناگهانی سیستم در هنگام نزدیک بودن سیگنال‌ها به آستانه گیت استفاده می‌شود



✓ طراحی رابطه کاربری

تعریف رابطه کاربری: هر محصولی که برای انسان طراحی شده باید توسط انسان قابل استفاده باشد. وقتی می‌خواهید به در رو باز کنید، دستگیره چیزیه که باعث میشه بتونید بازش کنید. اگه دستگیره (یا هر چیز جایگزین) نبود، «در» قابل استفاده نبود.

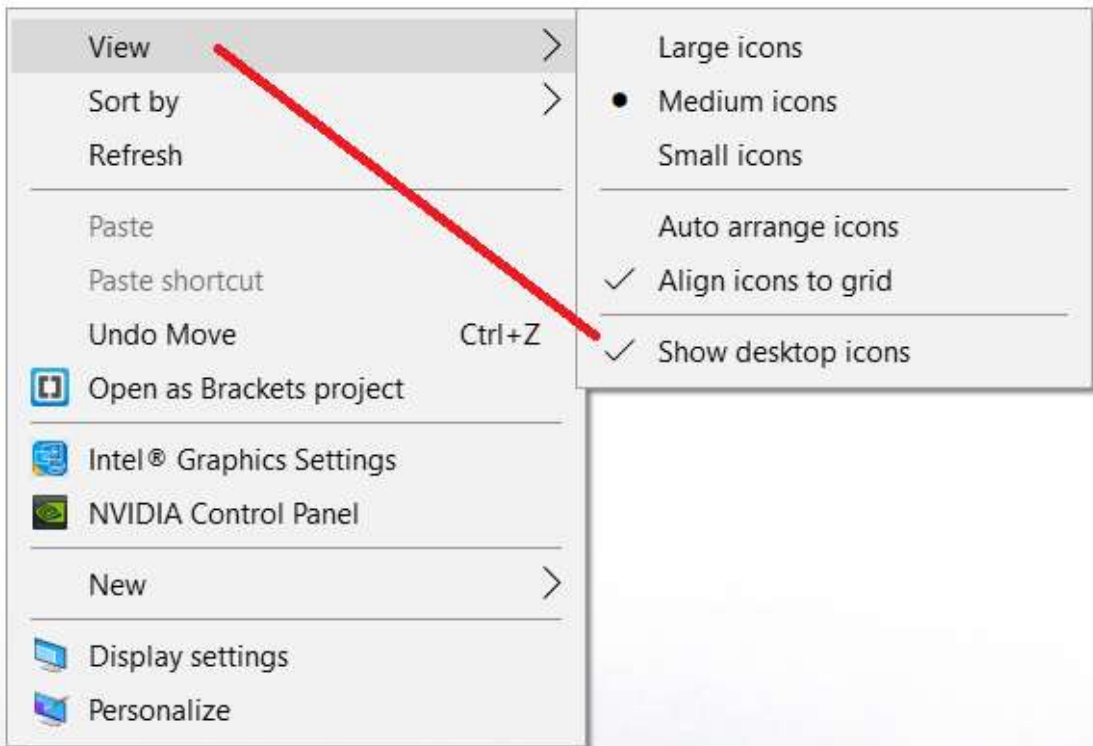
رابط کاربری در کامپیوتر: رابط کاربری فضاییه که تعاملات بین انسان و ماشین درش اتفاق میفته!

هیستریزیس در برخی از مواقع به درون الگوریتم‌های کامپیوتری نیز اضافه می‌شود. حوزه طراحی رابطه کاربری از اصطلاح هیستریزیس برای اشاره به تأخیرهای زمانی وارد شده برای تغییر وضعیت رابط کاربری در پس‌زمینه ورودی کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پدیده اهمیت بسیار زیادی در ساخت منوها و کنترل‌ها دارد.

به عنوان مثال، منوی ظاهر شده پس از کلیک راست بر روی صفحه دسکتاپ کامپیوتر را در نظر بگیرید (تصویر زیر). این منو دارای چندین گزینه به همراه زیرمنو است.

در صورت حرکت موس به سمت یک گزینه دیگر، منوی جانبی با یک تأخیر زمانی محو خواهد شد. این تأخیر زمانی همان پدیده هیستریزیس است. کاربرد این هیستریزیس هنگامی مشخص می‌شود که بخواهید از روی یک مسیر غیر مستقیم به سمت یکی از گزینه‌های منوی جانبی حرکت کنید (تصویر زیر). تأخیر زمانی اعمال شده، فرصت کافی برای انتخاب گزینه مورد نظرتان را پیش از محو شدن منوی جانبی فراهم می‌کند.

اگر موقعیت نشانگر موس را روی یک گزینه داری زیرمنو (دارای علامت فلش) قرار دهید، یک منوی جانبی (زیرمنو) در کنار منوی اصلی ظاهر می‌شود.



زیست‌شناسی سلولی ✓

پدیده هیستریزیس در زیست‌شناسی سلولی در اغلب موارد از سیستم‌های دارای دو پیروی می‌کند. در سیستم‌های (Bistable) «حالت پایدار یا اصطلاحاً «دو پایدار دو پایدار، یک ورودی مشابه می‌تواند دو خروجی پایدار متفاوت را در پی داشته باشد. در صورت تبدیل ورودی‌های شیمیایی به خروجی‌های دیجیتال با استفاده از خاصیت دوپایداری، وجود هیستریزیس باعث افزایش مقاومت این سیستم‌ها در برابر نویز می‌شود. در سیستم‌های دو پایدار، معمولاً مقادیر ورودی مورد نیاز برای تغییر وضعیت به یک حالت مشخص در مقایسه با مقادیر مورد نیاز برای باقی ماندن در وضعیت فعلی بیشتر است. این ویژگی، امکان تغییر وضعیت مداوم را از بین می‌برد و احتمال وجود نویز در سیستم را نیز کاهش می‌دهد.

✓ تقسیم سلولی

سلول‌هایی که در حال انجام **تقسیم سلولی** هستند نیز پدیده هیستریزیس را از خود به نمایش می‌گذارند. به دلیل وجود هیستریزیس در این فرآیند، تمرکز چرخه‌های سلولی بر روی تغییر وضعیت از فاز **G2** به میتوز بیشتر از تمرکز چرخه‌ها بر روی باقی ماندن در مرحله میتوز است.

✓ ژنتیک

دارلیگن (Darlington) در مطالعات کلاسیک خود بر روی موضوع ژنتیک، به بحث در مورد پدیده هیستریزیس کروموزوم‌ها پرداخته است. او عدم موفقیت بخش بیرونی کروموزوم‌ها در واکنش به تنش‌های داخلی ناشی از تغییرات ساختار حلزونی مولکول‌هایشان به هنگام قرارگیری در یک محیط تقریباً سخت در درون فضای محدود هسته سلول‌ها را به عنوان هیستریزیس کروموزوم در نظر می‌گیرد.

سلول T ، یکی از انواع **گلبول‌های سفید** است که در کنترل دستگاه ایمنی بدن و سازگاری آن با محیط نقش مهمی را ایفا می‌کند. بر اساس برخی از شواهد، **فعال‌سازی مجدد سلول‌های T** که قبلاً وضعیت فعال بودن را تجربه کرده‌اند، به **آستانه سیگنال کمتری** نیاز دارد.

به منظور شروع عملکردهای افکتور سلول‌های T ، در ابتدا باید سیستم فعال‌کننده مشبک (Reticular Activating System) یا اصطلاحاً «RAS» را فعال کرد. راه‌اندازی **گیرنده‌های سلول T** نیز به فعال‌سازی RAS در سطوح بالا نیاز دارد. این مسئله باعث تجمع سطوح بالایی از **پیوند GPT** یکی از وضعیت‌های فعال RAS بر روی **پوسته سلول** می‌شود. در نهایت، به دلیل وجود RAS فعال شده بر روی سلول‌های T ، گیرنده‌های این سلول‌ها با دریافت **سیگنال‌های ضعیف‌تر** نیز به **وضعیت فعال قبلی** بازمی‌گردند. دلیل این امر، وجود میزان زیادی RAS فعال بر روی سلول‌های دارای سابقه تحریک نسبت به سلول‌های ساده است. این مثال، **اهمیت و کاربرد** پدیده هیستریزیس در سیستم ایمنی بدن را نمایش می‌دهد.

✓ فیزیولوژی تنفس

هیستریزیس ریه، پدیده‌ای است که باعث ایجاد تفاوت بین نسبت تغییر حجم ریه به تغییر فشار آن در حالت دم و بازدم می‌شود. دلیل این تفاوت، انرژی اضافی مورد نیاز برای غلبه بر نیروهای کشش سطحی در حین دم به منظور به کارگیری و باد کردن کیسه‌های هوای ریه است. منحنی فشار در برابر حجم دم با منحنی فشار در برابر حجم بازدم تفاوت دارد. این تفاوت، پدیده هیستریزیس در فرآیند تنفس را نمایش می‌دهد. حجم ریه برای هر فشار مشخص در حین دم، کمتر از این حجم برای هر فشار مشخص در حین بازدم است.

تلفات منحنی پسماند

هسته های مغناطیسی دارای شار پسماند هستند. به این معنی که پس از صفر شدن میدان مغناطیسی، شار مغناطیسی هسته صفر نمی شود. برای صفر کردن این شار مغناطیسی مقداری انرژی صرف می شود که به صورت حرارت در هسته تلف می شود. این انرژی تلف شده را تحت عنوان تلفات هیستریزیس نامگذاری می کنیم. تلفات هیستریزیس ارتباطی با بار خروجی ترانسفورماتور ندارد و به فرکانس و جنس هسته بستگی دارد. در واقع مساحت داخل حلقه هیستریزیس، بیان گر تلفات هیستریزیس است که از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$P_h = K_h f B_{max}^{1.6}$$

سیاس از توجه شما

ارائه دهندگان:

نگار پرداختیم
محمدحسین مهاجر

ساخت پاورپوینت :

فائزه جمشیدی